## Universidade de São Paulo Instituto de Matemática e Estatistica IME



Patrícia da Silva Rodrigues (nºUSP 11315590),

- 1. Mostre o desenho (usando ou a nota, cão do diagrama de palito com cores ou a nota, cão sem cores, como vistas em aula) de
  - (a) uma porta NOR de tr^es entradas
  - (b) uma porta NAND de tr^es entradas. Resposta:

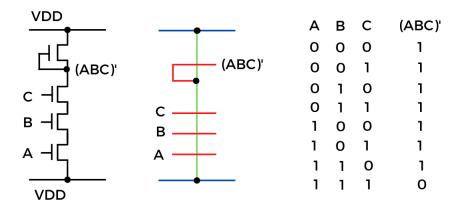


Figura 1: NAND

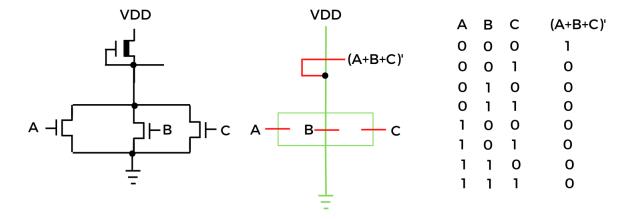


Figura 2: NOR

2. Qual dessas f'ormulas abaixo representam a resist^encia efetiva de condu¸c~ao ref de um transistor MOS? (Basta escolher uma das alternativas.)

(a) 
$$ref = \alpha \frac{W}{L}$$

(b) 
$$ref = \frac{\alpha L}{W}$$
  
(c)  $ref = \frac{L^2}{W^2}$   
(d)  $ref = \alpha \sqrt{\frac{L}{W}}$ 

(e) Nenhuma das anteriores.

Resposta: (B)  $ref = \frac{\alpha L}{W}$ 

- 3. Qual das duas tecnologias 'e a mais utilizada hoje? (Basta escolher uma das alternativas.)
  - (a) Tecnologia NMOS.
  - (b) Tecnologia CMOS.

Resposta: (B) Tecnologia CMOS.

4. Desenhe dois transistores A e B de comprimentos e larguras apropriados tal que A tenha resist^encia de condu¸c˜ao 8 vezes maior que B. Indique no desenho as medidas de comprimento e largura do transistor A (LA e WA) e do transistor B (LB e WB). Indique tamb´em os nomes das camadas: isto ´e, poli-sil´ıcio, difus˜ao.

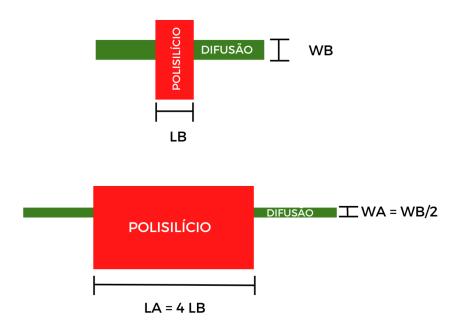


Figura 3: Transistores e B

$$ref = \frac{\alpha L}{W}$$
 $ref = \frac{\alpha L_A}{W_A}$ 

$$\frac{\alpha L_A}{W_A} = \frac{\alpha 4 * L_B}{\frac{W_B}{2}}$$

$$\frac{\alpha 4.L_B}{\frac{W_B}{2}} = \alpha.8.\frac{L_B}{W_B}$$

$$\frac{\alpha 2.4.L_B}{W_B} = 8.\frac{L_B}{W_B}$$

$$\frac{\alpha 8.L_B}{W_B} = \alpha.8.\frac{L_B}{W_B}$$

$$\alpha.8.\frac{L_B}{W_B} = \alpha.8.\frac{L_B}{W_B}$$

Outra solução possível é aumentar o tamanho de  $L_A$  em 8 vezes e não mudar o tamanho do canal de difusão. Caso o ambos estejam usando o mesmo tamanho de canal, essa solução pode ser boa.